

## Тематический указатель статей, опубликованных в 2002 году

### Фундаментальные исследования

*Апраксин Д.В., Коркишко Ю.Н., Федоров В.А.* Восстановление профиля показателя преломления в градиентных планарных световодах. № 6, с. 3.

*Мороча А.К., Егоркин В.И.* К теории распространения и усиления поверхностных акустоэлектрических волн в гетероструктурах на основе GaAs. № 6, с. 10.

*Герасименко Н.Н., Павлюченко М.Н., Джаманбалин К.К., Сайфутдинова Л.Р.* Фрактальный анализ поверхности слоя  $\text{CoSi}_2$ , полученного ионным синтезом. № 6, с. 17.

### Материалы электронной техники

*Антюшин В.Ф., Буданов А.В., Татохин Е.А., Болдырева Я.А.* Физико-химическая модель начальной стадии формирования гетероструктур селенид галлия – арсенид галлия, полученных методом гетеровалентного замещения мышьяка селеном. № 2, с. 29.

*Антюшин В.Ф., Буданов А.В., Татохин Е.А., Татохина Я.А.* Особенности диффузионного перераспределения примесей в гетероструктурах  $\text{A}_2^{\text{III}}\text{B}_3^{\text{VI}} - \text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ . № 5, с. 9.

*Великовский Л.Э., Китиченко Т.С., Колесникова Т.Г., Коровин А.П., Мазотов В.А., Мокиров В.Г., Якунин С.Н.* Глубокие центры захвата в структурах на основе GaN. № 6, с. 25.

*Вигдорович В.Н., Каримбеков М.А.* Выбор, разработка и совершенствование материалов термоэлектрических преобразователей. № 2, с. 23.

*Вигдорович В.Н., Каримбеков М.А.* Графоаналитическое определение пригодности материалов для термоэлектрических преобразователей измерительного назначения. № 3, с. 3.

*Максимов С.К.* Структурная неоднородность кристаллов  $\text{BaF}_2$ . № 4, с. 7.

*Патрушева Т.Н., Цыбалюк Т.С., Полякова К.П., Середкин В.А., Холькин А.И.* Магнитные пленки с ультрадисперсной структурой, полученные экстракционно-пиролитическим методом. № 2, с. 17.

*Фокин А.Г., Софронов В.М.* Макроскопические свойства фотонных кристаллов. № 5, с. 3.

*Шарин А.Г., Батюня Л.П., Раскин А.А., Рыжов М.В.* Моделирование процесса роста зерен при спекании керамических материалов. № 2, с. 33.

### Вакуумная электроника

*Быков Д.В., Кройчук К.Л., Симонов В.П., Черкасов А.С.* Особенности ионной проницаемости барьерных пленок с толщинами до 10 нм на входе микроканальных пластин. № 3, с. 12.

### Технология микроэлектроники

*Антоненко К.И., Райнов А.Ю.* Компенсация неоднородностей температурного поля подложки в быстрых термических процессах. № 1, с. 28.

*Александров О.В.* Моделирование перераспределения бора при совместной диффузии с фосфором в кремнии. № 1, с. 23.

**Бабкин С.И., Киреев В.Ю.** Процессы и оборудование физического осаждения из газовой фазы в технологии интегральных микросхем. Современное состояние: возможности, особенности, ограничения. № 1, с. 7.

**Галкин Н.Г., Конченко А.В., Маслов А.М., Ваванова С.В.** Формирование и свойства тонких пленок сплавов  $\text{Cr}_x\text{Fe}_{1-x}\text{Si}_2$  на Si(111). № 2, с. 37.

**Горнев Е.С., Зайцев Н.А., Лукерьян В.В., Матюшкин И.В., Зайцев А.Н.** Математическая модель неоднородности толщины эпитаксиального слоя кремния, полученного дихлорсилановым методом. № 3, с. 17.

**Зенин В.В., Полнер Г.Л., Беляев В.Н., Сегал Ю.Е.** Пайка золота в изделиях микроэлектроники оловянно-индиевыми припоями. № 3, с. 30.

**Неволин В.Н., Смирнов А.Л., Фоминский В.Ю., Костычев И.В., Кошманов В.Е.** Имплантация ионов в тонкие пленки при лазерном осаждении в импульсных электрических полях. № 4, с. 15.

**Петрова В.З., Тимошенков С.П., Чаплыгин Ю.А., Прокопьев Е.П.** Возможные синергетические подходы к исследованиям эволюции свойств структур КНИ. № 2, с. 44.

**Светличный А.М.** Моделирование распределения температуры при быстром нагреве структур  $\text{Mo-SiO}_2\text{-Si}$ . № 4, с. 29.

**Соколов В.И., Плотников В.В., Скворцов А.М., Фролова Е.Г., Халецкий Р.А.** Особенности термического окисления кремния, обусловленные структурным несоответствием на межфазной границе. № 5, с. 17.

**Суворов А.Л., Прокопьев Е.П., Залужный А.Г., Графутин В.И., Тимошенков С.П., Калугин В.В.** Исследование процесса очистки поверхности подложек с использованием методов термообработки во влажных условиях при получении структур КНИ. № 3, с. 24.

**Цепелев В.С., Белозеров В.Я., Влох А.Н., Конашков В.В., Шмакова К.Ю., Невидимова А.В.** Получение нанокристаллических материалов с уникальными магнитными свойствами. № 5, с. 13.

**Шерешевский Д.И., Вернер И.В.** Анализ динамической модели эволюции водорода, имплантированного в кремний. № 4, с. 23.

## Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

**Амеличев В.В., Тихонов Р.Д., Шорин М.В., Королев М.А., Чаплыгин Ю.А.** Исследование возможности повышения чувствительности биполярных латеральных магниточувствительных транзисторов. № 1, с. 40.

**Балашов А.М., Селищев С.В.** Экспоненциальная коррекция нелинейности температурного коэффициента напряжения  $p$ - $n$ -перехода для прецизионных источников опорного напряжения. № 5, с. 40.

**Булярский С.В., Серезжкин Ю.Н., Ионычев В.К., Кузьмин В.В.** Определение параметров глубоких центров, локализованных в микроплазменных каналах кремниевых лавинных диодов. № 2, с. 54.

**Воробьева Т.А., Гурин Н.Т.** Комбинированное полевое управление процессом переноса носителей заряда в многослойных полупроводниковых структурах. № 5, с. 22.

**Грушко Н.С., Лакалин А.В., Евстигнеева Е.А.** Исследование вольт-амперных характеристик и спектров электролюминесценции светодиодов с квантовой ямой, изготовленных на основе GaN. № 3, с. 48.

**Козлов Ю.Ф.** Оценка влияния технологических факторов на вольт-емкостные характеристики кремниевых детекторов ядерных частиц. № 4, с. 44.

- Лосев В.В., Лубегин Г.В., Орлов Б.М.* Характеристики фотоприемников на основе твердых растворов соединений  $Zn_{1-x}Cd_xS$  УФ- и видимой областей спектра. № 6, с. 39.
- Лугин А.Н., Оземша М.М.* Тонкопленочные резисторы с функциональным распределением удельного поверхностного сопротивления. № 1, с. 44.
- Лысенко А.П.* Полупроводниковые приборы на основе явлений токовой неустойчивости в  $p-n$ -переходах. № 3, с. 38.
- Малышев В.А.* Микроволновые гальваномагнитные эффекты с учетом разогрева носителей заряда постоянным полем. № 1, с. 35.
- Малышев В.А., Шибяев С.С., Филь К.А.* Анализ микроволновой проводимости полупроводника с омическими контактами. № 2, с. 51.
- Оболенский С.В.* Предел применимости локально-полевого и квазигидродинамического приближений при расчетно-экспериментальной оценке радиационной стойкости субмикронных полупроводниковых приборов. № 6, с. 31.
- Семенов А.А., Скворцов С.И., Вениг С.Б., Усанов Д.А.* Моделирование работы генератора релаксационных колебаний на магнитодиоде. № 3, с. 57.
- Сергеев В.А.* Токораспределение в терморезисторных структурах. № 4, с. 39.
- Усанов Д.А., Вениг С.Б., Горбатов С.С., Труфакин Э.В.* Влияние на спектр выходного сигнала СВЧ-генератора на диоде Ганна многочастотных НЧ-колебаний. № 4, с. 48.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В.* Оптическое управление полупроводниковыми синхронизированными СВЧ-генераторами, работающими в схеме вычитания сигналов. № 5, с. 31.
- Фёдоров И.А., Роцин В.М., Шевяков В.И.* Сканирующая силовая микроскопия с универсальным кантилевером. № 3, с. 61.
- Шерченков А.А.* Механизмы переноса носителей заряда в гетероструктурах  $a-Si:H/c-Si$  при прямом смещении. № 4, с. 34.

## Схемотехника и проектирование

- Беляев Д.А., Шишкевич А.А., Тикменов В.Н.* Синтез структурной схемы информационно-управляющей вычислительной системы с учетом территориальной распределенности. № 1, с. 49.
- Бородулин А.В., Курейчик В.М.* Эволюционный алгоритм канальной трассировки топологии СБИС. № 5, с. 52.
- Воробьев А.П.* Статистическое моделирование точностных характеристик аналого-цифрового преобразователя. № 1, с. 57.
- Гаврилов С.В., Глебов А.Л., Стемпковский А.Л.* Анализ помехоустойчивости цифровых схем на основе логических импликаций. № 5, с. 60.
- Курейчик В.М., Лебедев Б.К.* Генетический алгоритм трассировки в коммутационном блоке. № 4, с. 55.
- Кобяк И.П.* Булево-алгебраический метод контроля логики  $LSSD$ -устройств. № 2, с. 79.
- Мосин С.Г.* Подсистема САПР тестопригодного проектирования аналоговых схем. № 3, с. 67.
- Макарецкий Е.А., Щепакин К.М., Овчинников А.В.* Математические модели и методы синтеза нерегулярных многослойных оптических структур с резонансной угловой фильтрацией волновых полей. № 5, с. 45.

## Микросистемы

- Коноплев Б.Г., Лысенко И.Е.* Микрозеркало с электростатической активацией. № 4, с. 66.

## Микропроцессорная техника

*Итенберг И.И.* Мультипроцессоры для цифровой обработки изображений в системах реального времени. № 4, с. 71.

*Подлепецкий Б.И., Никифорова М.Ю., Гуменюк С.В.* Влияние светового излучения на параметры отклика интегральных сенсоров водорода. № 6, с. 44.

## Информационные технологии

*Варламов О.О.* Линейный матричный метод определения маршрута логического вывода на адаптивной сети правил. № 6, с. 48.

*Гагарина Л.Г., Морозова Н.В.* Алгоритм визуализации полноцветных изображений. № 5, с. 68.

*Комаров А.В., Малышев А.С., Иванушкин С.Ф., Лобынцев М.Ю.* Помехоустойчивый протокол обмена данными в инструментальной сети. № 2, с. 66.

*Корнилов К.А.* Язык для конфигурирования межсетевых экранов и реализаций Ipsec. № 6, с. 54.

*Костин А.Е., Гагарина Л.Г., Илюшечкина Л.В.* Исследование локальной вычислительной сети Ethernet с использованием модифицированных E-сетей. № 2, с. 72.

*Кучеров А.Н.* Создание единой системы электронных публикаций и депозитариев для хранения мультимедийной информации. № 1, с. 63.

*Минаков Е.И., Черешнев А.В., Горбатенко П.К.* Алгоритм обработки и распознавания одномерных сигналов, основанный на выделении формальных признаков в спектральной области. № 1, с. 67.

*Нестратов М.В.* Автоматизированная разработка помехоустойчивых кодеков в специализированной программной среде. № 6, с. 60.

*Умняшкин С.В.* Схема RD-оптимизированной компрессии для обработки видеоданных в реальном масштабе времени. № 2, с. 60.

## Интегральные радиоэлектронные устройства

*Арефьев А.С., Неганов В.А.* Исследование собственных волн многопроводной полосковой линии передачи с помощью метода частичного обращения сингулярного оператора. № 6, с. 66.

*Воронович В.В., Потапов А.Ю.* Широкополосный полигармонический транзисторный генератор. № 1, с. 70.

*Иванников Д.А., Иванников А.П.* Обобщенная интерполяционная формула в частотной области для неэквидистантных дискретных сигналов. № 6, с. 74.

*Касьянов А.О., Обуховец В.А.* Моделирование фазированных антенных решеток в интегральном исполнении. № 4, с. 79.

*Неганов В.А., Клюев Д.С.* Новый метод расчета полосковых вибраторных излучателей. № 5, с. 73.

*Роздобудько В.В., Пивоваров И.И., Червяков Г.Г.* Исследование точностных параметров акустооптических демодуляторов частотно-модулированных сигналов. № 4, с. 87.

*Титов А.А.* Параметрический синтез межкаскадной корректирующей цепи сверхширокополосного усилителя мощности. № 6, с. 81.

*Чистюхин В.В., Сизов В.И., Лялин К.С.* Мобильная антенна для приема программ цифрового спутникового радиовещания. № 1, с. 76.

*Чистюхин В.В., Лялин К.С.* Методика формирования контурных диаграмм направленности малоразмерных АФАР. № 2, с. 89.

## Методы и техника измерений

*Новиков С.Н., Тимошенков С.П.* Использование метода статического ионизированного конденсатора для измерения работы выхода электрона. № 5, с. 81.

*Новикова Н.М.* Электронное устройство для радиолокационного распознавания сигналов по яркости. № 5, с. 89.

## Биомедицинская электроника

*Новикова Н.М., Будко В.Н.* Способ и устройство для определения зрительного утомления оператора. № 2, с. 95.

*Новикова Н.М.* Автоматизация исследований психофизиологических характеристик человека-оператора. № 3, с. 74.

*Потапов Д.А.* Экспериментальное исследование лазерной томографической реконструкции радиально-симметричных сильно рассеивающих объектов. № 6, с. 88.

## Проблемы высшего образования

*Воробьев Н.В.* Организация эффективной работы со студентами в современных условиях. № 3, с. 83.

*Лучинин В.В., Тауров Ю.М.* Подготовка инженерных кадров по специальности «Микросистемная техника». № 3, с. 78.

## Краткие сообщения

*Артюшенков С.Н.* Создание Web-приложений с помощью средств быстрой разработки для Windows. № 1, с. 85.

*Бобринецкий И.И., Неволин В.К., Петрик В.И.* Ветвящиеся нанотрубки из углеродной смеси высокой реакционной способности. № 2, с. 105.

*Гайдуков Г.Н., Ланцова О.Ю.* Влияние короткодействующего взаимодействия ступеней вицинальных поверхностей полупроводников на формирование двух- и трехатомных ступеней и их эшелонирование. № 2, с. 101.

*Григорашвили Ю.Е., Ичкитидзе Л.П., Мингазин В.Т., Суханова Л.С.* Магнитная чувствительность сверхпроводниковых пленок  $\text{Bi}_{1,7}\text{Pb}_{0,4}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ . № 2, с. 103.

*Кириленко А.В.* Способ формирования сверхширокополосного импульсного зондирующего СВЧ-сигнала для радиолокационной аппаратуры. № 6, с. 92.

*Королев М.А., Красюков А.Ю., Тихонов Р.Д.* Применение диодов Шотки при формировании силовых планарных МОП-транзисторов. № 3, с. 89.

*Лубегин Г.В.* Индивидуальный дозиметр ультрафиолетового облучения. № 4, с. 94.

Памяти Александра Михайловича Прохорова. № 1, с. 88.

*Поголов А.И., Дарбинян А.В., Кожевников Я.С., Таран А.И.* Прочность УСУ-корпусов при термомеханических испытаниях. № 1, с. 81.

*Раджабов С.Г., Авдеев А.Ю., Казеннов Г.Г.* Моделирование непрямолинейных участков межсоединений ИМС. № 3, с. 87.

*Скубилин М.Д., Изотовс Д.А.* Измерение температуры поверхности тел с помощью двухчастотного пирометра. № 4, с. 92.

*Турулин И.И.* Особенности проектирования цифровых рекурсивных фильтров с квазиконечной импульсной характеристикой. № 1, с. 83.

*Шерешевский Д.И., Вернер И.В.* Модель эволюции водорода, имплантированного в кремний. № 3, с. 91.

### Юбилеи

В.Д. Вернеру – 70 лет. № 1, с. 5.

8 февраля – День российской науки. № 1, с. 4.

Каляеву А.В. – 80 лет. № 3, с. 94.

НИИ МВС – 30 лет. № 3, с. 97.

Таганрогскому государственному радиотехническому университету – 50 лет. № 4, с. 5.

### Московскому государственному институту электроники и математики – 40 лет

*Быков Д.В.* МИЭМ сегодня. № 2, с. 4.

*Арменский Е.В.* Рождение и становление МИЭМ. № 2, с. 10.

### Конференции. Семинары

Информация о IV международном научном семинаре «Карбид кремния и родственные материалы». № 1, с. 90.

Информация о Международной научно-технической конференции «СуперЭВМ и многопроцессорные вычислительные системы». № 1, с. 91.

Информация о международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники». № 1, с. 92.

Информация о IV международной научно-технической конференции «Электроника и информатика». № 1, с. 93.

9-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2002. № 3, с. 93.

Информация об объединенном заседании учебно-методических комиссий УМО по специальностям технических вузов. № 4, с. 96.

Открытие в МИЭТ Института проектирования приборов и систем. № 6, с. 94.